

Silicon Varicap Diode

BB112

UKW/VHF Tuning Diode

1..8,5V / 16,5-520pF

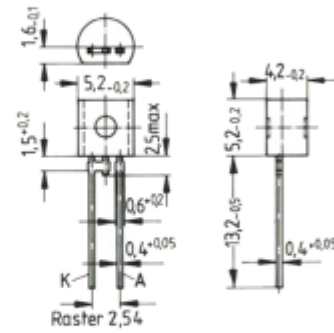
DATASHEET

OEM – Siemens

Source: Siemens Databook 1986/87

Silizium-Abstimm-diode**BB 112**

- Zur Frequenzabstimmung von AM-Empfängern
- Spezifizierter Durchstimm-bereich von 1 ... 8,5 V

TO 92

Typ	BB 112
Best.-Nr.	Q62702-B240

Grenzdaten

Sperrspannung	V_R	12	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
$T_A \leq 60^\circ\text{C}$			
Betriebstemperatur	T_{op}	-55...+ 85	$^\circ\text{C}$

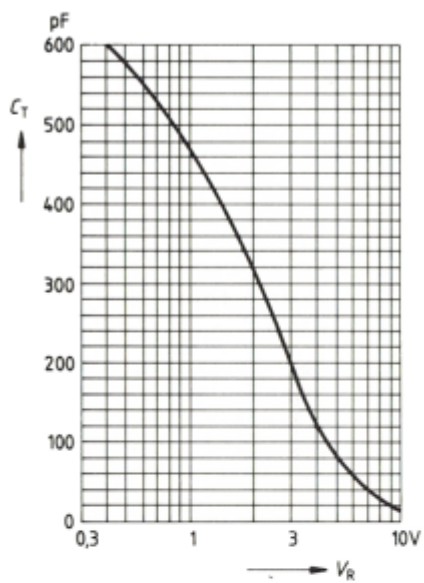
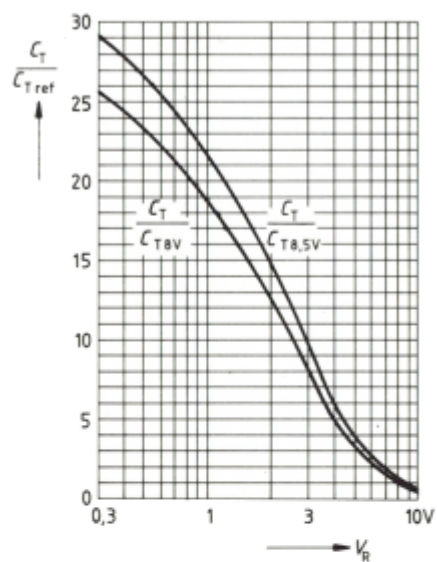
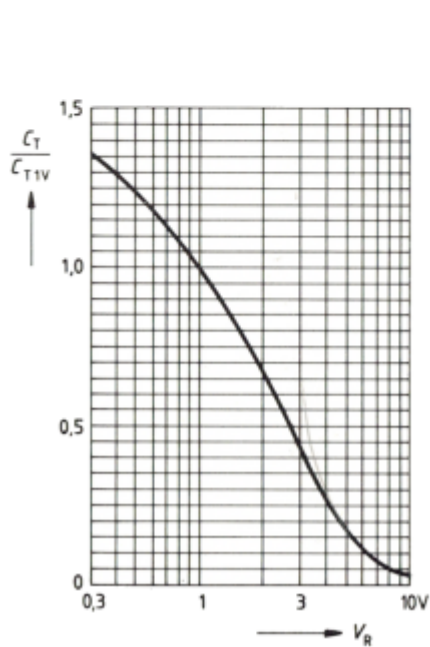
BB 112**Kenndaten** ($T_A = 25\text{ °C}$)**Gleichstromdaten**

		min	typ	max	
Sperrstrom	I_R	—	—	50	nA
$V_R = 10\text{ V}$		—	—	200	nA
$10\text{ V}, T_A = 60\text{ °C}$		—	—	—	—

Wechselstromdaten

Diodenkapazität, $f = 1\text{ MHz}$	C_T	440	470	520	pF
$V_R = 1\text{ V}$		16,5	—	29	pF
$8,5\text{ V}$		—	—	—	—
Kapazitätsverhältnis	$\frac{C_{T1}}{C_{T8,5}}$	18	—	—	—
$V_R = 1\text{ V}/8,5\text{ V}$		—	—	—	—
Serienwiderstand	r_s	—	1,4	—	Ω
$V_R = 1\text{ V}, f = 0,5\text{ MHz}$		—	—	—	—
Gütefaktor	Q	—	480	—	—
$V_R = 1\text{ V}, f = 0,5\text{ MHz}$		—	—	—	—
Temperaturkoeffizient der Diodenkapazität	TC_C	—	500	—	ppm/K
$V_R = 1\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		—	—	—	—
Kapazitätsgleichlauf in Bestückungssätzen	$\frac{\Delta C_T}{C_T}$	—	—	3	%
$V_R = 1 \dots 8,5\text{ V}$		—	—	—	—

BB 112

Diodenkapazität $C_T = f(V_R)$ Kapazitätshub
 $C_T/C_{Tref} = f(V_R)$ Kapazitätshub
 $C_T/C_{T1V} = f(V_R)$ Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazität
 $TC_C = f(V_R)$ 